

# Содержание

- XXIX Симпозиум „Нанофизика и нанoeлектроника“, Н. Новгород, 10–14 марта 2025 г.

**Капогузов К.Е., Мутилин С.В., Милюшин Д.М., Калинина В.Б., Волошин Б.В., Корольков И.В., Кичай В.Н., Яковкина Л.В., Селезнев В.А.**

Энергоэффективные и стабильные резистивные переключения в нанокристаллах диоксида ванадия . . . . . 123

**Власов А.С., Аксенов В.Ю., Анкудинов А.В., Берт Н.А., Калужный Н.А., Павлов Н.В., Пирогов Е.В., Салий Р.А., Сошников И.П., Щенин А.С., Минтаиров А.М.**

Сегнетоэлектрические свойства твердых растворов (Al,Ga)InP<sub>2</sub> . . . . . 130

**Колесина Д.Е., Кочетков Ф.М., Воробьев А.А., Новикова К.Н., Голтаев А.С., Мухин И.С.**

Эластичный светодиод на основе InGaN/GaN-нитевидных микрокристаллов с растяжимыми электродами на основе текстурированных одностенных углеродных нанотрубок и полидиметилсилоксана . . . . . 136

- Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

**Климов Е.А., Виниченко А.Н., Васильевский И.С., Клочков А.Н., Пушкарев С.С., Бурлаков И.Д.**

Влияние температуры роста на структурное совершенство пленок CdTe(111), синтезированных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs(100) . . . . . 141

**Иванова А.И., Корнева О.С., Божко И.А., Дектярев С.В., Гурулев А.В.**

Влияние плотности энергии высокоинтенсивного пучка ионов титана на накопление и диффузию в кремнии . . . . . 150

**Швец В.А., Марин Д.В., Азаров И.А., Якушев М.В.**

Влияние лучистого теплообмена на температуру роста при молекулярно-лучевой эпитаксии слоев HgCdTe . . . . . 153

- Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

**Зедоми Т.Э., Котова Л.В., Смирнов А.М., Кочерешко В.П.**

Поляризационная спектроскопия тонких пленок полимера F8BT поли(9,9-диоктилфлуорен-альт-бензотиадиазола) . . . . . 160

- Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

**Соболев М.М., Солдатенков Ф.Ю.**

Выявление условий формирования глубоких состояний дислокаций несоответствия и DX-центров в гетероэпитаксиальных слабелегированных Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As<sub>1-y</sub>Sb<sub>y</sub>/GaAs-слоях . . . . . 165

- Физика полупроводниковых приборов

**Ризаев А.Э., Подоскин А.А., Шушканов И.В., Капитонов В.А., Шашкин И.С., Вавилова Л.С., Слипченко С.О., Пихтин Н.А.**

Оптимизация дизайна гетероструктуры InGaAsP/InP мощных лазерных диодов, излучающих на длине волны 1.55 мкм . . . . . 171

**Вербицкая Е.М., Еремин И.В., Фадеева Н.Н., Еремин В.К., Зброжек В.О., Яблоков А.А., Исаков И.Д.**

Собирание заряда в кремниевых p<sup>+</sup>-n-n<sup>+</sup>-структурах при температуре 40 мК . . . . . 179